

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年2月3日(03.02.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/025033 A1

(51) 国際特許分類:
C04B 35/58 (2006.01) C23C 14/06 (2006.01)
C04B 35/56 (2006.01) C23C 14/34 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/027671

(22) 国際出願日: 2021年7月27日(27.07.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-129947 2020年7月31日(31.07.2020) JP
特願 2021-063955 2021年4月5日(05.04.2021) JP

(71) 出願人: 東ソー株式会社 (TOSOH CORPORATION) [JP/JP]; 〒7468501 山口県周南市開成町4 5 6 0 番地 Yamaguchi (JP).

(72) 発明者: 原 浩之 (HARA Hiroyuki); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川 2 7 4 3 番地 1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP). 召田 雅実 (MESUDA Masami); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川 2 7 4 3 番地 1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP). 増田 彩花 (MASUDA Ayaka); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川 2 7 4 3 番地 1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 T. S. パートナーズ, 外 (T.S. PARTNERS et al.); 〒1010048 東京都千代田区神田司町二丁目 8 番地 1 P MO 神田司町 3 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: Cr-Si-C-BASED SINTERED BODY

(54) 発明の名称: C r - S i - C 系焼結体

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a high density Cr-Si-C-based sintered body containing chromium (Cr), silicon (Si), and carbon (C), and to provide at least one of a further high density Cr-Si-C-based sintered body, a sputtering target containing same, and a method for manufacturing a film using said sputtering target. With the present invention, it is possible to provide a Cr-Si-C-based sintered body that contains chromium (Cr), silicon (Si), and carbon (C), and that is characterized by having a relative density of 90% or more and a pore percentage of 13% or less.

(57) 要約: 本発明の目的は、クロム (C r)、シリコン (S i)、カーボン (C) を含む高密度な C r - S i - C 系焼結体を提供すること、更には高密度な C r - S i - C 系焼結体、これを含むスパッタリングターゲット及び該スパッタリングターゲットを使用する膜の製造方法、の少なくともいずれかを提供することである。本発明により、クロム (C r)、シリコン (S i)、カーボン (C) を含む C r - S i - C 系焼結体であり、焼結体の相対密度が 90% 以上かつ、ポア率が 13% 以下であることを特徴とする C r - S i - C 系焼結体を提供すること、ができる。

WO 2022/025033 A1